

КТ872
п-р-п кремниевый
эпитаксиально-планарный
высоковольтный транзистор

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы (КТ872Г с демпфирующим диодом). Предназначены для применения в блоках питания, в схемах строчной развертки телевизионных приемников, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

Зарубежные прототипы

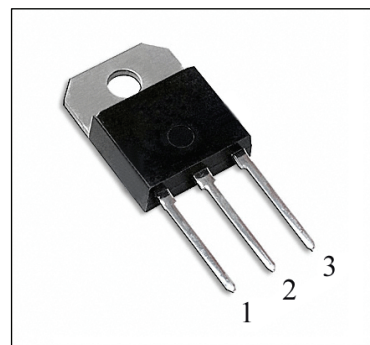
- Прототипы – BU508A, BU508, BU508D

Особенности

- Диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °С

Обозначение технических условий

- аАО.336.681 ТУ / 02



Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-43 (ТО-218) - КТ872А, Б, В, Г
- пластмассовый корпус КТ-43 ISOWATT (ТО-218 ISOWATT) - КТ872А1, Г1

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	База
№2	Коллектор
№3	Эмиттер

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ872 при $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозн.	Ед. изм	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор-эмиттер КТ872А, Б, Г, А1, Г1 КТ872В	Укэо гр.	В	$I_k=100\text{mA}$, $I_b=0$, $L=40\text{мГн}$	700 600	
Обратный ток коллектора КТ872А, Б, Г, А1, Г1 КТ872В	Ikэк	мА	Укэк =1500В $U_{бэ}=0$ Укэк =1200В $U_{бэ}=0$		1,0 0,6
Обратный ток эмиттера КТ872А, Б, В, А1 КТ872Г, Г1	Iэбо	мА	$U_{эб}=6\text{В}$	75	10 150
Статический коэффициент передачи тока КТ872В	h21э		$U_{кэ}=5\text{В}$, $I_k=0,03\text{А}$	6	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ872А, Г, А1, Г1 КТ872А, Г, А1, Г1 КТ872Б КТ872В	Укэ(нас)	В	$I_k=2,5\text{А}$, $I_b=0,6\text{А}$ $I_k=4,5\text{А}$, $I_b=2,0\text{А}$ $I_k=4,5\text{А}$, $I_b=2,0\text{А}$ $I_k=2,5\text{А}$, $I_b=1,0\text{А}$		0,5 1,0 5,0 1,0
Время спада КТ872А, Г, А1, Г1 КТ872Б, В	tсп.	мкс	$U_{кэ}=500\text{В}$, $I_k \text{ нас}=4,5\text{А}$		0,8 1,0
Время рассасывания КТ872А, Г, А1, Г1 КТ872Б, В	tрас.		$I_b \text{ нас}= I_b \text{ зап}=1,4\text{ А}$ $U_{бэ} \text{ зап} = -5\text{В}$		6,7 7,5
Постоянное прямое напряжение диода КТ872Г, Г1	Uпр.	В	$I_{пр}=4,5\text{А}$		2,0

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ872

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер: КТ872А, Б, Г, А1, Г1 КТ872В	Укэо max	В	700 600
Напряжение коллектор-эмиттер (импульсное): $U_{бэ} \leq 0\text{В}$, $Q \geq 4$, $t_u \leq 20\text{ мкс}$ КТ872А, Б, Г, А1, Г1 КТ872В	Укэ и max	В	1500 1200
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	6
Постоянный ток коллектора	$I_k \text{ max}$	А	8
Импульсный ток коллектора	$I_{ки} \text{ max}$	А	15
Постоянный ток базы	$I_b \text{ max}$	А	4
Импульсный ток базы	$I_{би} \text{ max}$	А	6
Постоянный запирающий ток базы	$I_b \text{ зап. max}$	мА	100
Импульсный запирающий ток базы	$I_b \text{ зап. и max}$	А	5
Рассеиваемая мощность коллектора: КТ872А, Б, В, Г КТ872А1, Г1	$P_k \text{ max}$	Вт	100 34
Температура перехода	T_j	$^{\circ}\text{C}$	150